



بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز، ایران.
۱۱-۹ بهمن ۱۳۹۷



مدولاتور الکترواپتیکی چند بانده مبتنی بر گرافن در بازه تراهرتز

بهنام جعفری^۱، هادی صوفی^۱، حمید واحد^۱، علی اکبر شوقی^۱

^۱دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه تبریز، تبریز ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱، ایران

چکیده - در این مقاله یک مدولاتور الکترواپتیکی چندباندده مبتنی بر گرافن تک لایه طراحی و مدلسازی شده است که در ساختار آن، نانو آنتن های فلزی برای افزایش جذب و بهبود مشخصات مدولاتور قرار گرفته است. با یکپارچه کردن گرافن با ساختار ساندویچی فلز/دی الکتریک/گرافن امواج پلاسمونی شدیداً حبس شده در سطح گرافن در داخل ساختار MDG تحریک شده و با انتشار در جهت متضاد آنها در سطح گرافن باعث ایجاد رزونانس فابری-پرو شده که باعث افزایش جذب مولتی باند در گرافن می شود. با اعمال ولتاژ بایاس طیف عبور مدولاتور شیفต์ پیدا می کند و بیشینه مقدار عبور از سیستم دستخوش تغییرات زیادی می شود. در طول موج $31.7\mu\text{m}$ می توان به عمق مدولاسیون در حدود ۱۸dB دست یافت. برخلاف دیگر مدولاتورهای مبتنی بر گرافن که اساس مدولاسیون از طریق اعمال تغییرات در جذب آن صورت می گیرد در این ساختار عمل مدولاسیون از طریق شیففت یافتن فرکانس پیک های عبور فابری-پرو اتفاق می افتد.

کلید واژه- مدولاتورهای الکترواپتیکی، گرافن پلاسمونیک، رزونانس فابری پرو.

Graphene based multiband THz electro-optic modulator

Behnam jafari¹, Hadi soofi¹, Hamid Vahed¹, Ali Akbar Shoghi¹

¹School of Engineering- Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz 5166616471, Iran

Abstract- In this article a multiband electro-optic modulator based on single layer graphene is designed and numerically investigated. The designed modulator incorporates metallic Nano-antennas to enhance the absorption and hence the modulator parameters. Due to integrating graphene into a metal-dielectric-graphene (MDG) sandwich structure, highly confined graphene plasmons (GPs) are excited in the MDG structure and multiple order Fabry-Perot (FP) resonances are formed by interference of oppositely propagating GPs waves that account for the multiband absorption enhancement. The applied bias voltage shifts the transmission spectra which in turn shifts the maximum transmission through the structure. At $31.7\mu\text{m}$, the modulation depth is as high as 18dB. Unlike other graphene-based modulators that modulation is based on changes in graphene absorption, in this case modulation is based on frequency shifting of FP resonances.

Keywords: Electro optical modulator, Graphene plasmonic, Fabry-Perot resonance.

مقدمه

بدلیل کاربردهای فراوان و روبه گسترش مدولاتورهای نوری مانند لیزرهای مدرن، مخابرات نوری و ارتباطات ترانزیت تحقیقات و پژوهش‌های مختلفی بر روی آنها انجام شده است [۱]. به لطف پیشرفت‌های اخیر و چشمگیر در علم نانو، تکنولوژی و دانش مواد، موادی با کاربردها و خصوصیات ویژه بصورت گسترده در ساخت و طراحی مدولاتورهایی با کاربردهای جدید و پارامترهای بهبود یافته، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال مواد گروه III-V [۲]، ژرمانیوم [۳]، پلیمرها و گرافن [۴] جای مناسبی در مدولاتورهای مبتنی بر سیلیکون برای بهبود پارامترهای کلیدی مانند عمق مدولاسیون، سرعت مدولاسیون، کاهش دادن اندازه‌ی مدولاتور، بهبود بازه‌ی طول‌موجی و دیگر پارامترهای مهم مدولاتورها کسب کرده‌اند. یکی از معایب مدولاتورهای ابتدایی مبتنی بر سیلیکون کم بودن عمق مدولاسیون در آنها بود برای غلبه بر این مشکل این مدولاتورها در اندازه بزرگی طراحی و ساخته می‌شدند و دلیل آن نسبتاً ضعیف بودن اثر الکترو-اپتیک آنها است. در مقابل استفاده از گرافن در مدولاتورهای نوری می‌تواند به محدودیت‌های سرعت، اندازه و عمق مدولاسیون غلبه کند. از ویژگی‌های منحصر بفرد گرافن می‌توان به دینامیک بسیار سریع حامل‌ها، جذب مستقل از طول موج [۵]، مشخصات نوری قابل تنظیم با استفاده از دوپینگ الکترواستاتیکی، نرخ تلفات کم، قابلیت تحرک بالا و توانایی حبس انرژی الکترومغناطیسی در حجم بسیار کوچک [۶] اشاره کرد. از طرف دیگر، میزان جذب نوری گرافن تک لایه برای یک موج الکترومغناطیسی که به صورت عمود بر آن بتابد، تقریباً مستقل از فرکانس نور و برابر با $\alpha\pi = 2.3\%$ است. یکی از روش‌های نوین پیشنهاد شده در سالیان اخیر برای افزایش اندرکنش موج الکترومغناطیسی با گرافن، استفاده از نانو ساختارهای فلزی و استفاده از اثرات پلاسمونیک

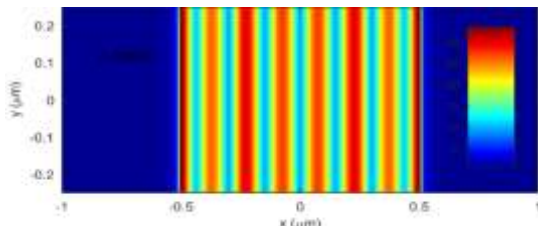
است. در پژوهش حاضر با استفاده گرفتن از مزایای گرافن، تحریک امواج پلاسمونی در آن و تداخل فابری پرو بین امواج پلاسمونی قطبیده شده توانستیم به طیف عبور چند بانده دست بیابیم بطوریکه با تنظیم ولتاژ گیت اعمالی به مدولاتور در هر طول موج دلخواه عمل مدولاسیون با بیشینه عمق مدولاسیون اتفاق می‌افتد. اساس مدولاسیون در این ساختار شیف‌ت طیف عبوری از سیستم است برای مثال با اعمال پالس الکتریکی با ولتاژ پایین ۰/۷ ولت و ولتاژ بالای ۱/۵ ولت در طول موج ۳۱ میکرومتر عمل مدولاسیون با بیشترین عمق مدولاسیون اتفاق می‌افتد بطوریکه طیف عبور سیستم در حدود ۷۰ درصد تغییر می‌کند. با افزایش ولتاژ گیت طول‌موج عملیاتی مدولاتور به سمت طول موج‌های پایین شیف‌ت پیدا می‌کند در حالیکه عمق مدولاسیون بیشترین مقدار خود را خواهد داشت.

طراحی مدولاتور

شکل ۱ ساختار مدولاتور پیشنهادی در سه و دو بعد را نشان می‌دهد. همانطور که دیده می‌شود نانو آنتن‌ها در هر دو طرف بالا و پایین گرافن قرار داده شده‌اند. نانو آنتن‌های بالایی توسط دی‌الکتریکی با ضخامت $5nm$ از گرافن جدا شده‌اند. عرض هریک از نانو آنتن‌ها $(W_t=W_b=1\mu m)$ است و فرض شده است که طول آنها L در مقابل عرضشان به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد. بستر سیلیکونی به ضخامت ۳ میکرومتر که به عنوان گیت برای کنترل پتانسیل الکتروشمیایی گرافن عمل می‌کند بطور مستقیم به نانو آنتن‌های پایینی متصل شده است. یک موج تخت با قطبش عمود بر نانوآنتن‌ها در راستای z - و واقع در نقطه‌ی $z=4\mu m$ به سیستم تابانیده می‌شود با گذر از مدولاتور موج نوری مدوله شده از پایین ساختار خارج می‌شود.

تحلیل نوری ساختار به روش FDTD انجام شده است که در آن طلا به عنوان ماده‌ای از جنس فلز با قابلیت گذردهی

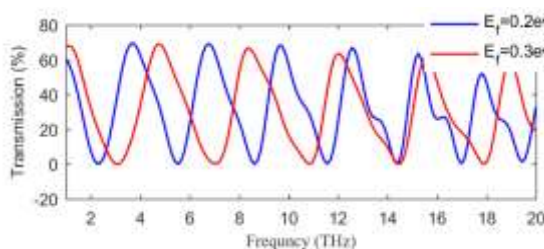
عبور از سیستم بیشترین مقدار خود را خواهد داشت و در فرکانس هایی که امواج پلاسمونی رونده در سطح گرافن تداخل سازگار دارند، مولفه ی میدان الکتریکی نور در سطح گرافن تلف می شود یا به عبارت دیگر در این فرکانس ها جذب گرافن بیشترین مقدار را خواهد داشت.



شکل ۲: توزیع میدان الکتریکی در سطح گرافن در فرکانس ۱۰ تراهرتز، رزونانس فابری پرو امواج پلاسمونی در سطح گرافن به وضوح قابل مشاهده است. مرتبه ب رزونانس در این فرکانس ۷ است.

نتایج و بحث

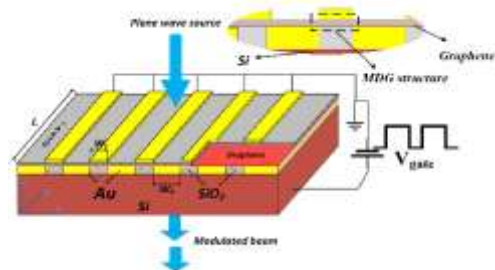
طیف عبوری از مدولاتور در شکل ۳ برای دو مقدار تراز فرمی نشان داده شده است. تعداد نقاط روشن و تاریک در توزیع میدان الکتریکی نشان داده شده است. لازم به ذکر است که بدلیل مقارن بودن ساختار مرتبه ی رزونانس فابری پرو همواره فرد خواهد بود. اگر M مرتبه ی رزونانس باشد در آنصورت طول موج امواج پلاسمونی از رابطه ی $\lambda_{GP} = 2W/M$ محاسبه می شود، که در آن W عرض نانواآنتن ها است. با افزایش فرکانس نور فرودی مرتبه ی رزونانس افزایش پیدا میکند.



شکل ۳: طیف عبوری مدولاتور برحسب فرکانس. دیده می شود که با تغییر اندک در تراز فرمی مقدار عبور در بعضی از فرکانس ها به مقدار قابل توجهی تغییر می کند.

تغییرات تراز فرمی گرافن بر حسب غلظت حامل ها در آن از رابطه ی $E_f = \hbar v_f \sqrt{\pi n}$ مشخص می شود و ولتاژ گیت

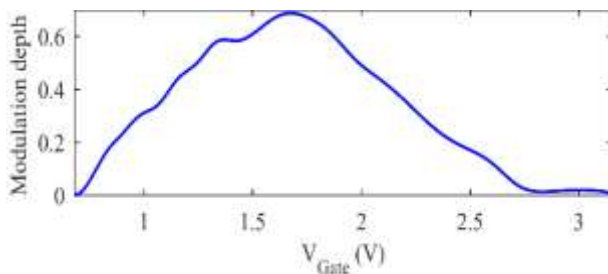
بدست آمده از آزمایشات تجربی مدل شده است. گرافن بصورت ماده ی دو بعدی با استفاده از هدایت سطحی آن مدلسازی شده است. معادلات هدایت سطحی گرافن از دو قسمت هدایت نوری مربوط به گذارهای بین بانندی و هدایت نوری متناسب با گذارهای درون بانندی تشکیل شده است. در بازه ی تراهرتز هدایت نوری گرافن بطور عمده توسط گذارهای درون بانندی آن مشخص می شود لذا می توان هدایت نوری گرافن را بصورت مدل شبه درود برای گذارهای درون بانندی بصورت رابطه ۱ بازنویسی کرد:



شکل ۱: ساختار مدولاتور. ناحیه ی مستطیلی مشخص شده در برش عرضی محدوده ی رزونانس فابری-پرو را نشان می دهد.

$$\sigma(\omega) = \sigma_{dc}(E_f) / (1 + \omega^2 \tau^2) \quad (1)$$

در معادله ی بالا $\sigma_{dc}(E_f)$ بیانگر هدایت الکتریکی dc گرافن است که وابسته به موقعیت تراز فرمی است. همانطوری که از معادله پیدا است، در این بازه جذب تراهرتزی گرافن می تواند بوسیله ی تنظیم تراز فرمی یا به عبارت دیگر دوپینگ گرافن مدوله شود. شکل ۲ توزیع میدان الکتریکی در سطح گرافن در فرکانس ۱۰ THz را نشان می دهد. بدلیل تقارن ساختار امواج پلاسمونی در هر دو سمت کانال گرافنی تحریک می شوند. این امواج پلاسمونی در سطح گرافن در جهت مخالف شروع به حرکت می کنند به عبارت دیگر گوشه های نانواآنتن طلا بصورت دو قطبی عمل می کند. با حرکت امواج پلاسمونی در سطح گرافن و تداخل آنها با یکدیگر باعث ایجاد تداخل فابری پرو در ساختار فلز/دی الکتریک/گرافن می شود. در فرکانس هایی که در آن تداخل امواج پلاسمونی باهم سازگار هستند طیف



شکل ۶: نمودار عمق مدولاسیون برحسب ولتاژ گیت اعمالی. عمق مدولاسیون در ۱/۶۷ ولت بیشترین مقدار را دارد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، یک مدولاتور تراهرتز مبتنی بر گرافن مورد طراحی و مدل سازی قرار گرفت. بر خلاف مدولاتورهای گرافنی مرسوم، در این ساختار از شیفت در فرکانس‌های رزونانس در ساختار فابری-پیرو در اثر تغییر در هدایت سطحی گرافن برای عمل مدولاسیون استفاده شده است. مدولاتور طراحی شده، دارای عمق مدولاسیون بسیار زیاد و ولتاژی عملکرد بسیار پایین است. برای مثال در طول موج ۳۱/۷μm برای داشتن عمق مدولاسیون ۷۰٪ تنها نیاز به تغییر ولتاژ اعمالی به گرافن به اندازه ۰/۶۷ V است.

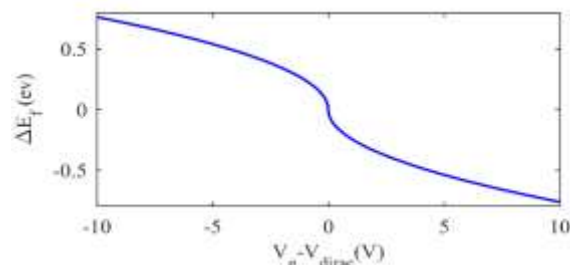
مرجع‌ها

- [1] L. Siyuan, W. Yanan, T. Xin, "Graphene-based optical modulators", Nanoscale research letters, Vol. 10, p. 199, 2015.
- [2] T. Yongbo, P. Jonathan, "Over 67 GHz bandwidth hybrid silicon electroabsorption modulator with asymmetric segmented electrode for 1.3μm transmission", Optics express, Vol. 20, pp. 11529-11535, 2012
- [3] C. Papichaya, M. Delphine, "23 GHz Ge/SiGe multiple quantum well electro-absorption modulator", Optics Express, Vol. 20, pp. 3219-3224, 2012.
- [4] L. Ming, Y. Xiaobo, "A graphene-based broadband optical modulator", Nature, Vol. 474, p. 64, 2011.
- [5] J. Dawlaty, S. Shivaraman, et al., "Measurement of the optical absorption spectra of epitaxial graphene from terahertz to visible", Applied Physics Letters, vol. 93, p. 131905, 2008.
- [6] A. Grigorenko, M. Polini K. Novoselov, "Graphene plasmonics", Nature Photonics, vol. 6, pp. 749-758, 2012.

طبق رابطه‌ی $n = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r V_g}{d_{ox}}$ باعث تغییر غلظت حامل‌ها در گرافن می‌شود. بنابراین طبق مدل صفحات خازنی:

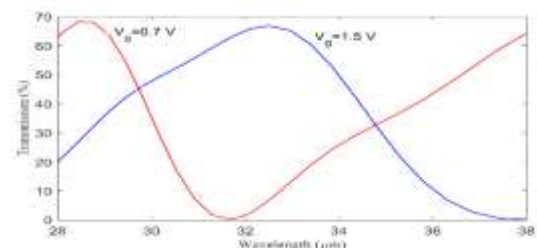
$$|\Delta E_f| = h \nu_f \sqrt{\frac{\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{e d_{ox}}} |V_g - V_{dirac}| \quad (2)$$

در رابطه‌ی بالا ϵ_0 ضریب گذردهی خلاء، ϵ_r ضریب گذردهی دی الکتریک، d_{ox} ضخامت دی الکتریک و $\nu_f \approx 10^6 \frac{m}{s}$ سرعت فرمی گرافن است. در شکل ۴ تغییرات تراز فرمی بر اثر اعمال ولتاژ بایاس نشان داده شده است.



شکل ۴: تغییرات سطح فرمی برحسب ولتاژ بایاس

برای یک بازه‌ی طول موجی محدودتر طیف عبور مدولاتور در شکل ۵ آورده شده است. وقتی که سطح پایین پالس اعمالی به گیت ۰/۷۷ V_{g1} باشد، کمترین مقدار عبور در طول موج ۳۱/۷μm اتفاق می‌افتد. با افزایش ولتاژ گیت عمق مدولاسیون بتدریج افزایش پیدا می‌کند و سپس بتدریج کاهش پیدا می‌کند. نمودار عمق مدولاسیون برحسب ولتاژ اعمالی در شکل ۶ آورده شده است. در ولتاژ $V_g = 1/67 V$ بیشترین عمق مدولاسیون برای طول موج ۳۱/۷μm بدست می‌آید که برابر با ۷۰٪ (۱۸dB) است.



شکل ۵: طیف عبوری مدولاتور به ازای ولتاژ گیت اعمالی مختلف